

Silicon PIN Diode

BA479G

30V / 50mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BA 479 G · BA 479 S

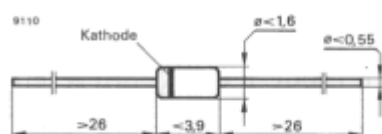
Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale:

- Großer Frequenzbereich 10 MHz ... 1 GHz

Abmessungen in mm



Standard Glasgehäuse
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempfung: Klartext

Absolute Grenzwerte

Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55 ... + 125	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	R_{thJA}	350	K/W
--	------------	-----	-----

Kenngößen

$T_{amb} = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung $I_F = 20 \text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom $U_R = 30 \text{ V}$	I_R			50	nA
Diodenkapazität $U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$	C_D			0,5	pF
Differentieller Durchlaßwiderstand $I_F = 1,5 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	r_f			50	Ω
Sperrimpedanz $U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$	z_r		4,5		k Ω
	z_r		9		k Ω

BA 479G · BA 479S